### Εύρεση ηλεκτρικού πεδίου από ηλεκτρικό δυναμικό

Είδαμε ότι η σχέση μεταξύ ηλεκτρικού δυναμικού και ηλεκτρικού πεδίου είναι:

$$\Delta V_e = \frac{\Delta U_e}{q} = -\int_A^B \left(\frac{\vec{F}_e}{q_0}\right) \cdot d\vec{s} = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Έστω ότι έχουμε δύο σημεία τα οποία απέχουν μικρή απόσταση,  $d\vec{s}$ , μεταξύ τους.

Η προηγούμενη σχέση οδηγεί στη διαφορική μορφή:  $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$ 

Χρησιμοποιώντας Καρτεσιανές συντεταγμένες:

$$\vec{E} = E_x \hat{\imath} + E_y \hat{\jmath} + E_z \hat{k} \quad \text{KQI} \quad d\vec{s} = d_x \hat{\imath} + d_y \hat{\jmath} + d_z \hat{k}$$

οπότε: 
$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s} = -(E_x \hat{\imath} + E_y \hat{\jmath} + E_z \hat{k}) \cdot (d_x \hat{\imath} + d_y \hat{\jmath} + d_z \hat{k}) = -(E_x dx + E_y dy + E_z dz)$$

Η τελευταία σχέση υποδηλώνει ότι: 
$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$
  $E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$   $E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$ 

Χρησιμοποιώντας τον τελεστή «del»: 
$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x} \hat{\imath} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{\jmath} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$$

Γράφουμε το ηλεκτρικό πεδίο:  $\vec{E} = E_x \hat{\imath} + E_y \hat{\jmath} + E_z \hat{k} \Rightarrow \vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x} \hat{\imath} - \frac{\partial V}{\partial y} \hat{\jmath} - \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k} \Rightarrow \vec{E} = -\nabla V$ 

Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι αν το ηλεκτρικό δυναμικό αυξάνει καθώς ένα θετικό φορτίο κινείται σε μια κατεύθυνση, έστω x, με  $\frac{\partial V}{\partial x} > 0$ , τότε υπάρχει μη μηδενικη συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου,  $-E_x \neq 0$ , στην αντίθετη κατεύθυνση.

# Εύρεση ηλεκτρικού πεδίου από ηλεκτρικό δυναμικό

Αν η κατανομή φορτίου έχει σφαιρική συμμετρία, τότε το ηλεκτρικό πεδίο είναι συνάρτηση της ακτινικής απόστασης r, δηλαδή  $\vec{E}=E_r\hat{r}$ 

Στην περίπτωση αυτή,  $dV = -E_r \hat{r}$ 

Αν γνωρίζουμε το V(r) τότε μπορούμε να βρούμε το  $\vec{E}$ :  $\vec{E} = E_r \hat{r} = -\left(\frac{dV}{dr}\right)\hat{r}$ 

Σαν παράδειγμα το ηλεκτρικό δυναμικό ενός σημειακού φορτίου είναι  $V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 

Από την προηγούμενη σχέση θα πάρουμε τότε:  $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \hat{r}$ 

εφαπτόμενη

## Κλίση και ισοδυναμικές

Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα σύστημα σε δύο διαστάσεις με δυναμικό *V*(x,y). Οι καμπύλες που χαρακτηρίζονται από σταθερό δυναμικό V(x,y) ονομάζονται

ισοδυναμικές καμπύλες

Σε τρεις διαστάσεις έχουμε ισοδυναμικές επιφάνειες και περιγράφονται από τη σχέση: V(x,y,z) = σταθ.

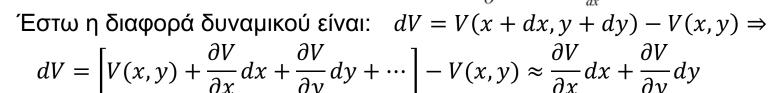
Εφόσον  $\vec{E} = -\nabla V$  μπορούμε να δείξουμε ότι η διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου  $\vec{E}$  είναι πάντα κάθετη στην ισοδυναμική στο σημείο τομής.

#### Απόδειξη:

Έστω ένα σημείο P(x,y) με δυναμικό  $V(x,y)^{dy}$ 

Έστω ένα γειτονικό σημείο P(x+dx,y+dy).

Πόσο μπορεί να αλλάξει το δυναμικό;



Αλλά το διάνυσμα της μετατόπισης είναι:  $d\vec{s} = dx\hat{\imath} + dy\hat{\jmath}$  και μπορούμε να γράψουμε:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial \dot{V}}{\partial y}\hat{\jmath}\right) \cdot (dx\hat{\imath} + dy\hat{\jmath}) \Rightarrow dV = (\nabla V) \cdot d\vec{s} \Rightarrow dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$$
Αν  $d\vec{s}$  κατά μήκος της εφαπτόμενης, τότε dV=0 (ισοδυναμική)

P(x+dx, y+dy)

P(x,y)



# Ισοδυναμικές



Τα χαρακτηριστικά των ισοδυναμικών επιφανειών είναι:

- (α) Οι ηλεκτρικές γραμμές είναι κάθετες πάντοτε στις ισοδυναμικές και έχουν διεύθυνση από υψηλότερο σε χαμηλότερο δυναμικό.
- (β) Λόγω συμμετρίας, οι ισοδυναμικές επιφάνειες που παράγονται από σημειακό φορτίο είναι πάντοτε ομόκεντρες σφαίρες και για σταθερό ηλεκτρικό πεδίο, δημιουργούν μια οικογένεια από επίπεδα κάθετα στις γραμμές του πεδίου.
- (γ) Η εφαπτόμενη συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου κατά μήκος της ισοδυναμικής επιφάνειας είναι μηδέν, διαφορετικά θα υπάρχει έργο για την μετακίνηση φορτίου από ένα σημείο της επιφάνειας σε ένα άλλο.
- (δ) Δεν απαιτείται έργο για την μετακίνηση ενός φορτίου κατά μήκος μιας ισοδυναμικής επιφάνειας

### 1ο Παράδειγμα: Δυναμικό ομοιόμορφα φορτισμένης ράβδου

Θεωρούμε μια μη αγώγιμη ομοιόμορφα φορτισμένη ράβδο μήκους / και γραμμικής πυκνότητας φορτίου λ. Ποιο το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο P που βρίσκεται σε απόσταση y από τη ράβδο στην κατακόρυφο που περνά από το μέσο της ράβδου.

Θεωρούμε στοιχειώδες μήκος dx' το οποίο εμπεριέχει φορτίο  $dq = \lambda dx'$ .

Το στοιχειώδες φορτίο που δημιουργεί το πεδίο βρίσκεται στη θέση (x',0) ενώ το δοκιμαστικό φορτίο στη θέση P  $\mu \varepsilon$  συντεταγμένες (0,y)

Η απόσταση από την πηγή στο P είναι:  $\sqrt{{x'}^2 + y^2}$ 

Η συνεισφορά του στοιχειώδους φορτίου στο δυναμικό είναι:

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda dx'}{\sqrt{x'^2 + y^2}}$$

Θεωρούμε ότι το δυναμικό είναι 0 στο άπειρο.

Επομένως το δυναμικό εξαιτίας όλης της ράβδου θα είναι:

$$V = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{dx'}{\sqrt{x'^2 + y^2}} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left[x' + \sqrt{x'^2 + y^2}\right] \Big|_{-l/2}^{+l/2} \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left[\frac{(l/2) + \sqrt{(l/2)^2 + y^2}}{-(l/2) + \sqrt{(l/2)^2 + y^2}}\right]$$

#### 1º Παράδειγμα: Δυναμικό ομοιόμορφα φορτισμένης ράβδου

Το γράφημα του  $V(y)/V_0$  όπου  $V_0=\lambda/4\pi\varepsilon_0$ , συναρτήσει της ποσότητας y/l.

Στο όριο  $l\gg y$ , το δυναμικό γίνεται:

$$V = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} ln \left[ \frac{(l/2) + (l/2)\sqrt{1 + (2y/l)^2}}{-(l/2) + (l/2)\sqrt{1 + (2y/l)^2}} \right] = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} ln \left[ \frac{1 + \sqrt{1 + (2y/l)^2}}{-1 + \sqrt{1 + (2y/l)^2}} \right] \Rightarrow \frac{\delta_{\text{ΙΟ}} \delta_{\text{IO}} \delta_{$$

$$V \approx \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left[\frac{1 + \left\{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2y}{l}\right)^2\right\}}{-1 + \left\{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2y}{l}\right)^2\right\}}\right] = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left[\frac{2 + 2\left(\frac{y}{l}\right)^2}{2\left(\frac{y}{l}\right)^2}\right] \Rightarrow V \approx \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left[\frac{2}{2\left(\frac{y}{l}\right)^2}\right] = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left[\frac{1}{\left(\frac{y}{l}\right)^2}\right] = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left[\frac{l^2}{y^2}\right] \Rightarrow V \approx \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left[\frac{l}{y}\right]$$

Το αντίστοιχο ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τη σχέση:

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \Rightarrow E_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y} \frac{l/2}{\sqrt{(l/2)^2 + y^2}}$$

dq

#### 2º Παράδειγμα: Δυναμικό ομοιόμορφα φορτισμένου δακτυλίου

Θεωρούμε έναν μη αγώγιμο ομοιόμορφα φορτισμένο δακτύλιο ακτίνας R και γραμμικής πυκνότητας φορτίου λ. Ποιο το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο P που βρίσκεται σε απόσταση z από τον κεντρικό άξονα.

Θεωρούμε στοιχειώδες μήκος  $dl' = Rd\varphi'$ .

Το τμήμα αυτό εμπεριέχει φορτίο  $dq = \lambda dl' = \lambda R d\varphi'$ .

Το στοιχειώδες δυναμικό στο P θα είναι επομένως:

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda R d\varphi'}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

Το δυναμικό στο *P* θα είναι επομένως:

$$V = \int dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \oint d\varphi' \Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda 2\pi R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

Όταν  $z\gg R$ , το δυναμικό προσεγγίζεται με αυτό του σημειακού φορτίου:  $V\sim \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{Z}$ 

Το ηλεκτρικό πεδίο στην θέση P υπολογίζεται από τη σχέση:

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \Rightarrow E_z = -\frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Qz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

#### 3° Παράδειγμα: Δυναμικό ομοιόμορφα φορτισμένου δίσκου

Θεωρούμε μη αγώγιμο ομοιόμορφα φορτισμένο δίσκο ακτίνας *R* και επιφανειακής πυκνότητας φορτίου σ. Ο δίσκος βρίσκεται στο x-y επίπεδο. Να βρεθεί το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο *P* που βρίσκεται σε απόσταση *z* από τον κεντρικό άξονα.

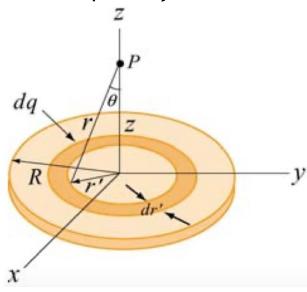
Θεωρούμε έναν δακτύλιο ακτίνας r' και πλάτους dr'.

Το φορτίο του στοιχειώδους αυτού δακτυλίου είναι:

$$dq = \sigma dA = \sigma \left( 2\pi r' dr' \right)$$

Το δυναμικό στο σημείο *P* εξαιτίας αυτού του στοιχειώδους φορτίου θα είναι:

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\sigma (2\pi r' dr')}{\sqrt{r'^2 + z^2}}$$



Αθροίζουμε (ολοκληρώνουμε) ως προς όλους τους στοιχειώδεις δακτυλίους που απαρτίζουν τον δίσκο:

$$V = \int dV = \frac{2\pi\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{(r'dr')}{\sqrt{r'^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{(r'dr')}{\sqrt{r'^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ \sqrt{r'^2 + z^2} \right]_0^R \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[ \sqrt{R^2 + z^2} - |z| \right]$$

#### 3° Παράδειγμα: Δυναμικό ομοιόμορφα φορτισμένου δίσκου

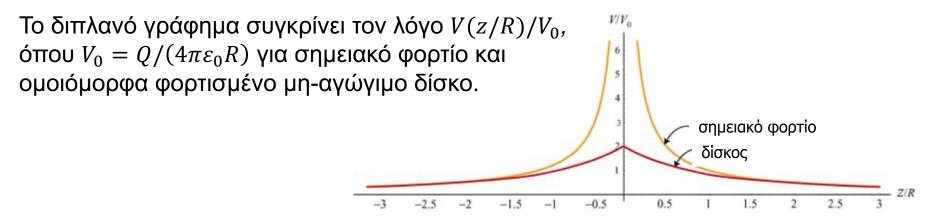
Στο όριο  $|z| \gg R$  μπορούμε να πάρουμε το διονυμικό ανάπτυγμα της  $\sqrt{R^2 + z^2}$  οπότε:

$$\sqrt{R^2 + z^2} = |z| \sqrt{\left(\frac{R}{z}\right)^2 + 1} = |z| \left[ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{R}{z}\right)^2 + \dots \right] = |z| \left( 1 + \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2} \right)$$

Οπότε το δυναμικό απλουστεύεται σε αυτό του σημειακού φορτίου:

$$V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}|z|\left[1 + \frac{R^2}{2z^2} - 1\right] \Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}|z|\frac{R^2}{2z^2} \Rightarrow V = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\frac{R^2}{|z|} \Rightarrow V = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\pi R^2}{|z|} \Rightarrow V = \frac{Q}{4|z|\pi\varepsilon_0}$$

Όπως είναι αναμενόμενο, το δυναμικό εξαιτίας ενός μη αγώγιμου δίσκου φορτίου Q είναι το ίδιο με αυτό που προκαλεί ένα σημειακό φορτίο Q.



#### 3° Παράδειγμα: Δυναμικό ομοιόμορφα φορτισμένου δίσκου

Βρήκαμε ότι το δυναμικό που προκαλεί φορτισμένος δίσκος ομοιόμορφης κατανομής φορτίου σε σημείο P σε απόσταση z είναι:  $V=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\Big[\sqrt{R^2+z^2}-|z|\Big]$  Το δυναμικό στο κέντρο του δίσκου (z=0) είναι:

$$V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} R = \frac{\sigma \pi R^2}{2\pi \varepsilon_0 R} = \frac{2Q}{4\pi \varepsilon_0 R} \Rightarrow V = 2V_0$$

Το έργο που χρειάζεται για να φέρουμε το μοναδιαίο φορτίο από το άπειρο στο κέντρο του δίσκου.

Το αντίστοιχο ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P θα είναι:

$$E_z = -rac{\partial V}{\partial z} = rac{\sigma}{2 arepsilon_0} \left[ rac{z}{|z|} - rac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} 
ight]$$
 που συμφωνεί με τον υπολογισμό ξεκινώντας από τον ορισμό του ηλεκτρικού πεδίου:

Στο όριο  $R\gg z$ , η εξίσωση δίνει  $E_z=\sigma/2\varepsilon_0$  που είναι το ηλεκτρικό πεδίο άπειρης μη-αγώγιμης επιφάνειας.

#### 4º Παράδειγμα: Υπολογισμός ηλεκτρικού πεδίου από δυναμικό

Έστω ότι το ηλετρικό δυναμικό εξαιτίας μιας κατανομής φορτίου γράφεται σε καρτεσιανές συντεταγμένες ως:

$$V(x, y, z) = Ax^2y^2 + Bxyz$$
 όπου  $A$ ,  $B$ , σταθερές.

Ποιο το ηλεκτρικό πεδίο που σχετίζεται με το δυναμικό αυτό;

Το ηλεκτρικό πεδίο βρίσκεται από τις εξισώσεις:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -2Axy^2 - Byz$$

$$E_{y} = -\frac{\partial V}{\partial y} = -2Ax^{2}y - Bxz$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -Bxy$$

Επομένως το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι:

$$\vec{E} = (-2Axy^2 - Byz)\hat{\imath} - (2Ax^2y + Bxz)\hat{\jmath} - Bxy\hat{k}$$